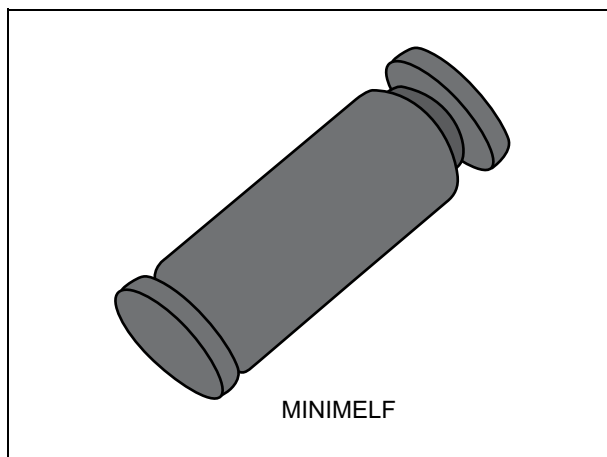




Description

General purpose metal to silicon diode featuring very low turn-on voltage and fast switching.

These devices have integrated protection against excessive voltage such as electrostatic discharges.

Features

- Very small conduction losses
- Negligible switching losses
- Low forward voltage drop

1 Characteristics

Table 1. Absolute maximum ratings at 25 °C unless otherwise specified

Symbol	Parameter		Value	Unit
V_{RRM}	Repetitive peak reverse voltage		30	V
I_F	Forward continuous current	$T_I = 25\text{ °C}$	200	mA
I_{FRM}	Repetitive peak forward current	$t_p \leq 1\text{ s}$ $\delta \leq 0.5$	500	mA
I_{FSM}	Surge non repetitive forward current	$t_p = 10\text{ ms}$	4	A
P_{tot}	Power dissipation	$T_I = 65\text{ °C}$	200	mW
T_{stg}	Storage temperature range		-65 to + 150	°C
T_j	Operating junction temperature range		-65 to + 125	°C
T_L	Maximum temperature for soldering during 15 s		260	°C

Table 2. Thermal resistance

Symbol	Parameter	Value	Unit
$R_{th(j-l)}$	Junction to leads	300	°C/W

Table 3. Static electrical characteristics

Symbol	Test conditions		Min.	Typ.	Max.	Unit
V_{BR}	$T_j = 25\text{ °C}; I_R = 100\text{ }\mu\text{A}$		30	-		V
$V_F^{(1)}$	$T_j = 25\text{ °C}; I_F = 200\text{ mA}$	All types		-	1	V
	$T_j = 25\text{ °C}; I_F = 10\text{ mA}$	TMMBAT42FILM		-	0.4	
	$T_j = 25\text{ °C}; I_F = 50\text{ mA}$			-	0.65	
	$T_j = 25\text{ °C}; I_F = 2\text{ mA}$		0.26	-	0.33	
	$T_j = 25\text{ °C}; I_F = 15\text{ mA}$	TMMBAT43FILM		-	0.45	
$I_R^{(1)}$	$T_j = 25\text{ °C}, V_R = 25\text{ V}$			-	0.5	μA
	$T_j = 100\text{ °C}, V_R = 25\text{ V}$			-	100	

1. Pulse test: $t_p = 380\text{ }\mu\text{s}$ $\delta < 2\%$

Table 4. Dynamic characteristics

Symbol	Test conditions	Min.	Typ.	Max.	Unit
C	$T_j = 25\text{ °C}; V_R = 1\text{ V}; f = 1\text{ MHz}$		7		pF
t_{rr}	$T_j = 25\text{ °C}; I_F = 10\text{ mA}; I_R = 10\text{ mA}; I_{RR} = 1\text{ mA}$ $R_L = 100\text{ }\Omega$			5	ns

Figure 1. Forward voltage drop versus forward current (typical values, high level)

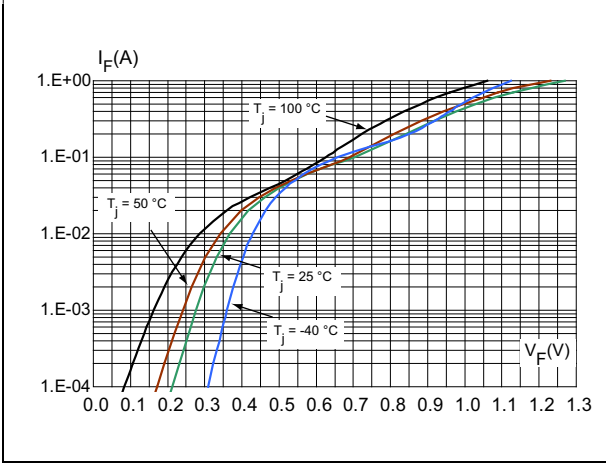


Figure 2. Forward voltage drop versus forward current (typical values)

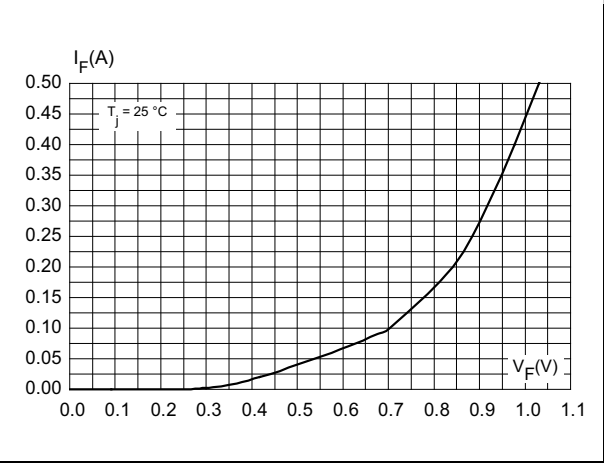


Figure 3. Leakage current versus reverse voltage applied (typical values)

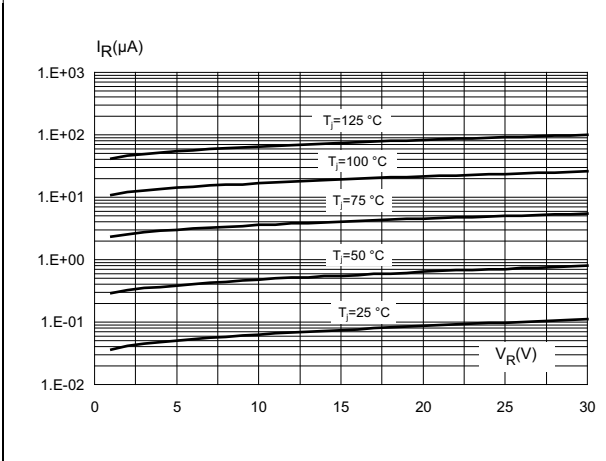
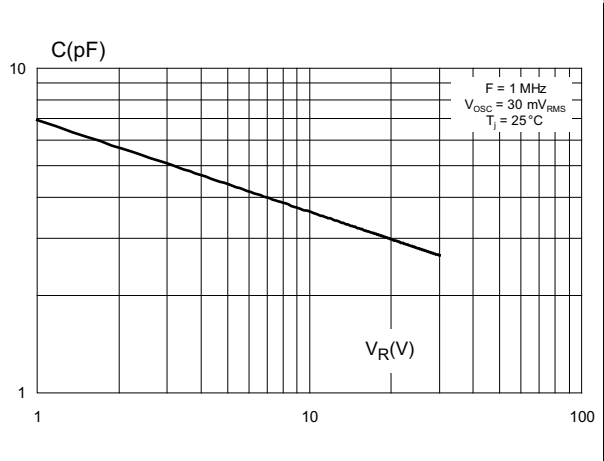


Figure 4. Junction capacitance versus reverse voltage applied (typical values)



2 Package information

- Ring at cathode end.

In order to meet environmental requirements, ST offers these devices in different grades of ECOPACK® packages, depending on their level of environmental compliance. ECOPACK® specifications, grade definitions and product status are available at: www.st.com. ECOPACK® is an ST trademark.

2.1 MINIMELF package information

Figure 5. MINIMELF package outline

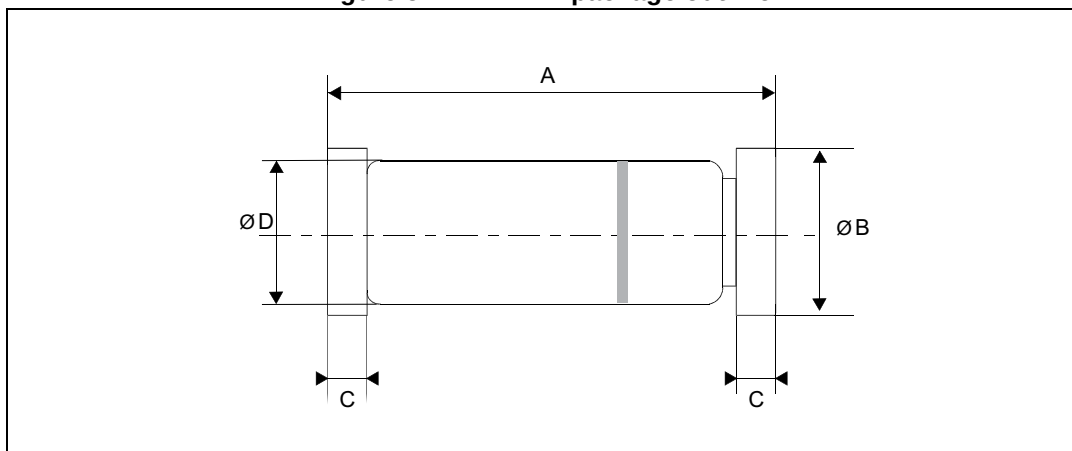
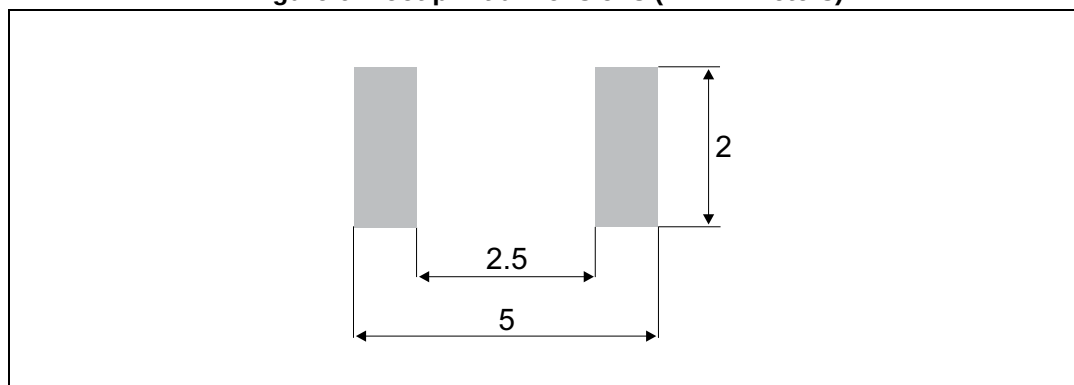


Table 5. MINIMELF mechanical data

Ref.	Dimensions					
	Millimeters			Inches		
	Min.	Typ.	Max.	Min.	Typ.	Max.
A	3.30	3.50	3.70	0.130	0.138	0.146
ØB	1.59	1.65	1.70	0.063	0.065	0.069
C	0.40	0.50	0.60	0.016	0.020	0.024
ØD		1.50			0.059	

Figure 6. Foot print dimensions (in millimeters)



3 Ordering information

Table 6. Ordering information

Order code	Package	Weight	Base qty	Delivery mode
TMMBAT42FILM	MINIMELF	40 mg	2500	Tape and reel
TMMBAT43FILM				

4 Revision history

Table 7. Document revision history

Date	Revision	Changes
Aug-1999	1A	Last issue.
31-Jul-2014	2	Reformatted to current standards. Added ordering information.
27-Jul-2015	3	Updated MINIMELF package information and reformatted to current standard. Updated Figure 1 , Figure 2 , Figure 3 , and Figure 4 .

IMPORTANT NOTICE – PLEASE READ CAREFULLY

STMicroelectronics NV and its subsidiaries ("ST") reserve the right to make changes, corrections, enhancements, modifications, and improvements to ST products and/or to this document at any time without notice. Purchasers should obtain the latest relevant information on ST products before placing orders. ST products are sold pursuant to ST's terms and conditions of sale in place at the time of order acknowledgement.

Purchasers are solely responsible for the choice, selection, and use of ST products and ST assumes no liability for application assistance or the design of Purchasers' products.

No license, express or implied, to any intellectual property right is granted by ST herein.

Resale of ST products with provisions different from the information set forth herein shall void any warranty granted by ST for such product.

ST and the ST logo are trademarks of ST. All other product or service names are the property of their respective owners.

Information in this document supersedes and replaces information previously supplied in any prior versions of this document.

© 2015 STMicroelectronics – All rights reserved



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331